

収束電子回折法による構造相転移の研究

津田 健治 東北大学 多元物質科学研究所

(受取日:2012年8月31日,受理日:2012年10月5日)

Study of Structural Phase Transformations Using Convergent-Beam Electron Diffraction

Kenji Tsuda Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University

(Received Aug. 31, 2012; Accepted Oct. 5, 2012)

The convergent-beam electron diffraction (CBED) technique and its applications to phase transformations are described. Point- and space-group determination, nanometer-scale crystal structure refinement and electrostatic potential analysis using CBED are presented along with examples of the low-temperature ferromagnetic insulator phase of $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ (x = 0.12) and the orbital-ordered phase of FeCr₂O₄.

Keywords: convergent-beam electron diffraction (CBED), phase transformation, point and space groups, crystal structure and electrostatic potential analysis



津田 健治 Kenji Tsuda E-mail: k_tsuda@tagen.tohoku.ac.jp

1. はじめに

構造相転移における結晶構造の変化、すなわち結晶の対 称性(点群・空間群)や原子の微小な変位を調べるために は、X線・中性子回折が用いられるのが普通です。しかし ながら, X線・中性子回折を用いて点群・空間群を決定す ることは、それほど容易ではありません。これは、X線・ 中性子回折では多くの場合一回散乱(運動学的回折)がほ ぼ成り立ち,hkl反射とhkl反射の強度が等しくなるためで す(フリーデル則)。このため中心対称の有無が判別できず、 ラウエ群(中心対称を持つ11個の点群)までしか判別でき ません。32 個の点群を判別するためには、圧電性などの物 性測定や異常分散効果の利用が必要になります。また、相 転移に伴い導入される微小な双晶・ドメイン構造は、さら に問題を困難にします。このような場合、収束電子回折 (Convergent-beam electron diffraction: CBED) と呼ばれる手 法が有効です。CBED 法では、電子線の強い多重散乱(動 力学回折)効果を利用して中心対称の有無を判別して点群 を一意に決定できます。さらに動力学的消滅則と呼ばれる 効果を用いてらせん軸・映進面の判別を行うことが可能で, ほとんどの空間群を判別できます。1-3)実際,X線・中性子 回折で空間群が判別困難な試料に対して CBED 実験を行う 例が増えています。また、CBED 法ではナノメーターサイ ズに収束した電子線を用いるので、複雑な双晶・ドメイン 構造などがあっても単結晶領域を選択して解析することが できます。さらに、CBED 法は、相転移にともなう原子位 置・熱振動や静電ポテンシャル分布のわずかな変化をとら える定量的な結晶構造解析が可能です。4-9)

本稿では収束電子回折法について簡単に紹介し,構造相 転移研究への適用例を示します。

2. 収束電子回折法について

CBED 法は、円錐状に収束させた電子線を試料のナノメ ーターサイズの領域に照射して回折図形を得る方法で、分 析タイプの透過型電子顕微鏡で容易に実行できます。^{2,9)} Fig.1 に通常の制限視野電子回折 (Selected area electron diffraction: SAED) 法と CBED 法での光線図を示します。



Fig.1 Ray path diagrams of SAED and CBED methods.

SAED 法では平行な電子線を試料に照射して,対物レンズの後焦点面上に回折スポットを得ます。一方, CBED 法では電子線を円錐状に収束して試料に照射し,入射電子線の角度の広がりに応じて各回折波がディスク状に広がった図形を得ます。CBED 法では入射方向の違いによる回折波の強度変化を見ていることになります。このため SAED 図

形よりも格段に多い情報が CBED 図形から得られます。

実例として,実験で得た SrTiO₃ [001]入射の SAED 図形 および CBED 図形を Fig.2 に示します。SAED 図形のスポ ット状の回折波が CBED 図形ではディスク状になり,ディ スク内に強度分布が現れていることがわかります。この強 度分布には,[001]軸に関する 4 回回転対称,{100}面につ いての鏡映対称および{110}面についての鏡映対称(それぞ れ図中で m, m'と示した),すなわち対称性 4mm が見られ ます。これは,電子線入射方向から投影した試料の 2 次元 的な対称性を表しています。SAED 図形からこのような対 称性の情報を読み取るのは困難です。

SAED 法では電子線の照射領域は通常100 nm 程度より大きく,領域内での試料の厚さ・方位の変化は避けられません。一方 CBED 法では,試料厚さ・方位が一定とみなせるようなナノ領域を選択できるので,定量解析に耐える回折強度データが得られるという特徴もあります。



Fig.2 SAED (left) and CBED (right) patterns of SrTiO₃ taken at [001] incidence.



Fig.3 [001] CBED pattern of SrTiO₃ including HOLZ reflections and the corresponding Ewald sphere and reciprocal lattice

Fig.3は, **Fig.2**と同じ CBED 図形をより広い角度範囲で 表示したものです。中心の四角で囲った領域が **Fig.2**に対

Netsu Sokutei 39 (4) 2012

応します。中心から離れたところ(高角側)にリング状に 配列した強度が見られます。これに対応する逆格子点と Ewald 球(横から見た)を図の上部に示しました。Fig.2で 示したような CBED 図形の中心領域にある回折ディスクは 逆格子空間の原点付近で Ewald 球の近くにある逆格子点に 対応し, Fig.3 の高角側のリング状に並んだ回折ディスクは 高角側で Ewald 球の近くにある上の層の逆格子点に対応し ます。これらはそれぞれ、零次ラウエ帯(Zeroth-order Laue zone: ZOLZ)反射,高次ラウエ帯(Higher-order Laue zone: HOLZ)反射と呼ばれます。HOLZ反射は入射方向の逆格子 ベクトル成分を含むため、投影ではなく試料の3次元的な 対称性が現れます。この場合 HOLZ反射は ZOLZ と同じく 対称性 4mm を示しています。

構造相転移における結晶対称性変化の検出

CBED 図形に現れる対称性を利用して,結晶点群・空間 群が決定できます。点群・空間群決定の流れは次のように なります¹⁻³⁾。

 <u>CBED</u> 図形の撮影: 複数の異なる入射方位から CBED 図形を撮影します。ひとつの方位からは,晶帯 軸入射の CBED 図形 (Zone-axis pattern: ZAP),晶体軸 から電子ビームをわずかに傾斜してある回折波 G を Bragg 条件に励起したもの,回折波-G を Bragg 条件に 励起したものの計 3 枚の CBED 図形を撮影するのが標 準的なやり方です。Fig.4 に,Si [110]入射の 3 枚の図 形の例を示しました。+DP, -DP ではそれぞれ 002 回 折ディスクと002回折ディスクが Bragg 条件を満たし ています。



Fig.4 CBED patterns used for point-group determination. Zone-axis pattern (ZAP) and two dark patterns (+DP and -DP). Transmitted and Bragg-excited disks are indicated with dotted and solid circles, respectively.

 (2) 回折群の決定: (1)で述べた3枚のCBED図形から, Whole pattern (WP), Bright-field pattern (BP), Dark-field pattern (DP), ±DPと呼ばれる4つの図形の対称性を 読み取ります。ここで、WPはZAP全体の対称性, BP はWPのうち透過ディスク(000)のみの対称性, DPは 回折ディスクG内の対称性, ±DPは+G波のDP(+DP) と-G波のDP(-DP)を並べた図形(試料の同じ領域から 撮影した2枚の写真)を表します。WP, BP, DP, ±DPに 現れ得る対称性を **Fig.5** に模式的に示しました。各図 形がどの対称性を持っているかを読み取ります。±DP は中心対称性の有無を判別するために重要です。**Fig.4** の場合, WP および BP の対称性はどちらも 2*mm*, DP の対称性は $2m_vm_2$, ±DP の対称性は $21_Rm_v(m_v)$ と読み取 ることができます。

WP, BP, DP, ±DP の対称性から対応表を参照して回 折群を決めます。^{1,3)}回折群とはある入射の CBED 図 形で得られる対称性を表すもので 31 種類あります。 Fig.4 の場合には回折群は $2mm1_R$ となります。回折群 の詳細については参考文献をご参照ください。^{1,3)}



Fig.5 Schematic diagram of symmetries appearing in WP, BP, DP and \pm DP.

- (3) 点群の決定: 幾つかの方位で回折群が決まると,回 折群と点群の対応表^{1,3)}を利用して可能な点群の候補 を絞り込み,点群を決定できます。
- (4) 格子型の決定:回折波の運動学的消滅則から格子型 (ブラベー格子)を決めます(格子形による消滅則は 多重散乱で破れることはありません)。
- (5) 空間群の決定:点群・格子型が決まると可能な空間群 の候補が絞れます。ここで動力学的消滅則(Dynamical extinction)を調べてらせん軸・映進面の有無を調べ, 空間群を判別します。動力学的消滅則とは多重散乱効

果により起きる消滅則です。すべての空間群 230 個の 各入射方位に対してどの反射に動力学的消滅則が現れ るかが表として与えられています。¹⁾



点群・空間群決定の例として La_{1-x}Sr_xMnO₃ (x = 0.12)への 適用例を示します。¹⁰⁾ この物質は ABO₃のペロブスカイト 型構造を持ち, A サイトに La および Sr, B サイトに Mn が 位置します。室温の常磁性絶縁体相から温度を下げると, 中間相の強磁性金属相を経て, 145 K 以下の低温強磁性絶 縁相に構造相転移することが知られています。^{11,12)} 粉末中 性子回折実験¹²⁾からは,室温相,中間相,低温強磁性絶縁 体相は同じ空間群 Pnma に属し,単位胞は $\sqrt{2}a_{pc} \times \sqrt{2}b_{pc} \times$ $2c_{pc}$ とに属すると報告されていました(ここで a_{pc}, b_{pc}, c_{pc} は擬立方ペロブスカイト構造の格子定数)。一方,単結晶中 性子回折¹²⁾ からは,粉末回折の結果と異なり,低温強磁性 絶縁体相が $2a_{pc} \times 2b_{pc} \times 4c_{pc}$ の超格子構造を持つと報告 されましたが,その空間群は明らかにされていませんでし た。このため低温強磁性絶縁体相に CBED 法が適用されま

した。 まず SAED 図形から 145 K 以下の低温相は、中性子回折 の結果とは異なり、2*a_{pc}*×4*b_{pc}*×4*c_{pc}*の単位胞を持つこと が明らかにされました。Fig.6(a), Fig.6 (b), Fig.6 (c)にそれぞ れ[100], [010], [001]入射の低温相の単ドメインから得た CBED 図形を示します。相転移にともない複雑な双晶ドメ イン構造が導入されますが、CBED 図形は単ドメインのナ ノサイズの領域から得られました。どの図形でも、中心部 の ZOLZ 反射と一番外側の強い HOLZ 反射の間に、矢印で 示した弱い HOLZ 反射によるリングが見られます。これら の弱い HOLZ 反射は、低温相でのみ現れる超格子反射であ り、低温相構造の対称性を決定する上で重要です。

Fig.6(a)の CBED 図形を見ると,強度の強い基本反射は 145 K 以上の斜方晶相と同様のほぼ 2mm の対称性を示して いますが,図中の矢印で示した弱い超格子反射の強度を詳 細に見ると,WPの対称性は1,すなわち対称性を持たない ことがわかります。同様に,Fig.6(b)および Fig.6(c)もWP の対称性は1です。これらの対称性と回折群の関係および 回折群と点群の関係の表を参照すると,可能な点群は三射 晶系の1もしくは-1に絞られます。

Fig.7(a)と**Fig.7 (b**)は, [010]入射からわずかに結晶を傾け て,それぞれ 001 反射と001反射(室温相の単位胞での指 数)を Bragg 条件に励起して得た CBED 図形です。001 反 射と 00-1 反射は,室温相の空間群 *Pbmn* では禁制反射です が,低温相では十分な強度があります。**Fig.7(a**)の 001 反射 ディスクと **Fig.7(b**)の001反射ディスクの強度分布は,平行 移動して重なる対称性を有していることがわかります。これは **Fig.5** の±DP の対称性のうち $2_{\rm R}$ と表されます。これは 点群が 1 でなく中心対称性を持つ1であることを示してい ます。ここから,空間群は三斜晶系のP1と一意に決定でき ました。¹⁰⁾



Fig.6 CBED patterns of the low-temperature phase of $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ (x = 0.12) taken at 90 K with (a) [100], (b) [010] and (c) [001] incidences. Super lattice reflections of higher-order Laue zone are indicated by arrowheads, showing no symmetries.

Fig.7 CBED patterns of the low-temperature phase of $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ (*x*=0.12) taken at the exact Bragg conditions of (a) 001 and (b) 001 reflections by slightly tilting the specimen form the [010] incidence.

この結果は、それまで報告されていた粉末中性子回折¹²⁾ および単結晶中性子回折の結果¹³⁾と異なるもので、ナノサ イズの電子プローブを用いて単ドメインから回折データが 得られる CBED 法ならではのものと言えます。

4. 結晶構造・静電ポテンシャル分布解析

CBED 法を用いて定量的な結晶構造解析を行うことが可 能です。試料の厚さ・方位一定のナノメーター領域から得 た CBED 図形の回折強度分布を,多重散乱計算(動力学回 折理論計算)による強度と定量的に比較して,結晶構造パ ラメーター(原子位置・熱振動パラメーター・低次結晶構 造因子など)を精密化することができます。われわれのグ ループは,ハードウェア・ソフトウェア両面の開発により, このような解析を世界で初めて実現しました。^{49,14)}



Fig.8 Procedure of crystal structure analysis using CBED.



Fig.9 Energy-filtered CBED pattern of the low-temperature phase of $FeCr_2O_4$ taken at 90 K with [110] incidence.

解析手順は Fig.8 のようになります。まず CBED 図形を 撮影しますが,定量解析を可能にするために,エネルギー フィルターを搭載した透過型電子顕微鏡を用います。非弾 性散乱バックグラウンドを除去して CBED 図形を取得しま す。この図形から電子レンズによる歪みの補正等を行って 各回折ディスクの二次元強度分布を取り出します。また, 精密化する結晶構造パラメーター(原子位置・原子変位パ ラメーター・占有率・低次結晶構造因子)を含む結晶構造 モデルを作成して動力学回折強度計算を行います。これら, 実験と計算の二次元強度分布を非線形最小二乗法に基づい て定量比較し,結晶構造パラメーターを精密化します。こ れら結晶構造パラメーターからフーリエ合成によって単位 胞内の静電ポテンシャル分布を得ます。さらに Poisson 方 程式を通して電子密度分布まで得られます。

結晶構造・静電ポテンシャル分布解析の例として, FeCr₂O₄ の軌道秩序相転移への適用を紹介します。¹⁵⁾ FeCr₂O₄はFeO₄四面体とCrO₆八面体からなる正スピネル構 造をとります。室温の立方晶相から約 135K で正方晶相へ 構造相転移を起こしますが、¹⁶⁾これに伴い Fe 原子の 3d 電子の e 軌道が軌道秩序を示すと予想されていました。¹⁷⁾ CBED 法で軌道秩序状態のこの Fe 原子まわりの静電ポテ ンシャル分布を観測し、軌道秩序による微小な変化を見出 しました。

構造解析に先立ち,前節と同様に CBED による空間群決 定を行い,低温相の空間群を $I4_1/amd$ (no. 141)と決定しまし た。Fig.9 に,FeCr₂O₄低温相の[110]入射で得た CBED 図形 を示します。弱い反射に着目すると対称性は立方晶相の 4 mm から破れて 2 mm となっています。また高次ラウエ帯 反射の作る図形から格子定数を a = 5.93(2) Å, c = 8.26(3) Å と決定しました。[110],[100],[210]入射 CBED 図形の定量 解析を行って原子位置・異方性原子変位パラメーター・低 次結晶構造因子を精密化しました。その結果,FeO₄四面体 が c 方向に圧縮され,FeO₄四面体の Fe-O ボンド間の角度 が,室温立方晶相の 109.5°から 111.8°に増加しているこ とがわかりました。さらに、精密化した原子位置・原子変 位パラメーターおよび低次結晶構造因子から静電ポテンシ ャル分布および電子密度分布を得ました。



Fig.10 (a) 4 e/Å^3 isosurface of FeO₄ tetrahedron of the room temperature phase colored with electrostatic potential and (b) that of the low-temperature phase. (c) Schematic diagram of Fe 3*d* orbital-ordered state.

Fe の 3d 電子の変化を詳細に見るために、FeO₄四面体を 取り出して 4 $e/Å^3$ 等電子密度面上の静電ポテンシャル分布 をプロットしたものを Fig.10 に示します。Fig.10(a)および 10(b)はそれぞれ室温相および 90 K での低温相での結果で す。室温では、隣接する酸素イオンの電子の影響により静 電ポテンシャルが低下しているのが見られるだけですが、

低温相では、これに加えて等電子密度面の c 軸に沿う方向 (図に矢印で示した上下方向)でも静電ポテンシャルが低 下しています。これは、c 軸に沿う方向で電子密度が増加 していることを意味し、Fe 3d 電子の 3z²-r²型軌道が c 軸に 沿う向きに存在していることを示しています。この軌道は、 Fig. 10(c)に示したように、単位胞中のすべての FeO₄四面体 で同じ c 軸方向を向いたフェロ的軌道秩序となっており、 軌道秩序を直接観測したものと言えます。

軌道秩序によるわずかな電子密度分布の異方性を静電ポ テンシャル分布を通して直接観察したのはこの解析¹⁵⁾が初 めてです。

5. おわりに

CBED 法の概略を紹介し, CBED 法による結晶点群・空間群の決定と,定量的な結晶構造・静電ポテンシャル分布解析について,構造相転移物質への適用例を示しました。

CBED 法は,特に,X線・中性子回折法では得られない, ナノスケールの局所構造情報が得られる特徴を生かして, 様々な応用が期待できます。われわれのグループでは,現 在,強誘電体の構造相転移に伴い生成するナノドメインの 詳細な解析を進めています。

謝 辞

日頃から多大なサポートをいただいている東北大学多元 物質科学研究所の寺内正己教授に感謝いたします。

文 献

- M. Tanaka, "*International Tables for Crystallography*", ed. U. Shumueli, 3rd edn., Vol. B, pp.307-356, IUCr, Springer, Dordrecht (2008).
- 2) 津田健治, 顕微鏡 44, 280-285 (2009).
- M. Tanaka and K. Tsuda, J. Electron Microsc. 60 (sppl. 1), S245-S267 (2011).
- 4) K. Tsuda and M. Tanaka, Acta Cryst. A55, 939-954 (1999).
- 5) K. Tsuda, K. Takagi, Y. Ogata, T. Hashimoto, and M. Tanaka, *Acta Cryst.* A58, 514-525 (2002).
- Y. Ogata, K. Tsuda, and M. Tanaka, Acta Cryst. A64, 587-597 (2008).
- 7) 津田健治, 日本結晶学会誌 52, 184-189 (2010).
- 8) 津田健治, 日本結晶学会誌 53, 380-386 (2011).
- 9) 津田健治、「第5版実験化学講座11巻:物質の構造III 回折」、日本化学会編、丸善、分担執筆、9.1章、 pp.421-452 (2006).
- 10) K. Tsuda, M. Tanaka, K. Hirota, and Y. Endoh, J. Phys. Soc. Jpn. 70, 1101-1105 (2001).
- 11) Y. Endoh et al., Phys. Rev. Lett. 82, 4328-4331 (1999).
- 12) H. Kawano et al., Phys. Rev. B 53, R14 709-14712 (1996).
- 13) Y. Yamada et al., Phys. Rev. Lett. 77, 904-907 (1996).
- 14) M. Tanaka, K. Tsuda, M. Terauchi, K. Tsuno, T. Kaneyama, T. Honda, and M. Ishida, J. Microsc. 194, 219-227 (1999).
- 15) K. Tsuda, D. Morikawa, Y. Watanabe, S. Ohtani, T. Arima, *Phys. Rev. B* 81, 180102(R)-1-4 (2010).
- 16) G. Shirane, D. E. Cox, and S. J. Pickart, J. Appl. Phys. 35, 954-955 (1964)
- 17) T. Arima, Y. Watanabe, K. Taniguchi, M. Watanabe, and Y. Noda, J. Magn. Magn. Mater. 310, 807-809 (2007).